



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100628001

2010 年 7 月 1 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタムドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-DFABサイト製造 TLV2371/TLV271 製品 ウェーハサイズ追加変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)	☐ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☒ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	TI-DFABサイト製造 TLV2371/TLV271製品 ウェーハサイズ追加変更 現行：150mm径ウェーハ 変更後：150mm径ウェーハ、200mm径ウェーハ	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	10 月上旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-DFAB(Dallas, 米国) サイト製造 TLV2371/TLV271製品について、現行 LBC3Sプロセス 150mmウェーハ前処理にて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、LBC3Sプロセス 200mmウェーハ前処理での製造を追加する予定です。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ウェーハサイズ	150mm径ウェーハ	150mm径ウェーハ 200mm径ウェーハ

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
MP1TLV2371-W	TLV2371IDBVTG4	TLV271CD	TLV271CDR	TLV271IDBVTG4
SN1003028DBVR	TLV2371IDG4	TLV271CDBVR	TLV271CDRG4	TLV271IDG4
TLV2371ID	TLV2371IDR	TLV271CDBVRG4	TLV271ID	TLV271IP
TLV2371IDBVR	TLV2371IDRG4	TLV271CDBVT	TLV271IDBVR	TLV271IPE4
TLV2371IDBVRG4	TLV2371IP	TLV271CDBVTG4	TLV271IDBVRG4	
TLV2371IDBVT	TLV2371IPE4	TLV271CDG4	TLV271IDBVT	

信頼性試験

信頼性試験計画					
信頼性試験期間	開始	2010 年 7 月	終了	2010 年 7 月	
信頼性試験 － 試料構成詳細					
Qual Device:	TLV271ID	Die Size (mm):	38.35 X 29.45		
Wafer Fab Site:	DFAB (DL-LIN)	Wafer Fab Process:	LBC3S		
Wafer Size:	200 mm	Metallization:	TiW/AISiCu.5		
Die Protective Coating:	10KACN	-	-		
信頼性試験計画					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Per Spec	Per Spec	Per Spec	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Per Spec	Per Spec	Per Spec	

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2002 年 2 月 22 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	SN104605PN	Die Size (mm):	3.302 X 6.1976		
Wafer Fab Site:	DFAB (DL-LIN)	Wafer Fab Process:	LBC3S		
Wafer Size:	200 mm	Metallization:	TiW/AlCu.5		
Die Protective Coating:	10KACN	-	-		
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
**Life Test	155C, 1000 Hours	116/0	116/0	116/0	
**Biased Hast	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0	
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
ESD-CDM	500 Volts	3/0	3/0	3/0	
ESD-HBM	2500, 3000 Volts	3/0	3/0	3/0	
ESD-MM	200 Volts	3/0	3/0	3/0	
Bond Strength	-	76/0	76/0	76/0	
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0	
Electrical Characterization	-	50/0	50/0	50/0	
Manufacturability (Wafer Fab)	-	Approved	-	-	
Manufacturability (Assembly Site)	-	Approved	-	-	
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/220C					